



手 続 補 正 書

(法第11条の規定による補正)



特許庁審査官 河口 雅英 殿

1. 国際出願の表示 PCT/JPO3/05334

2. 出願人

名称 サンケン電気株式会社

SANKEN ELECTRIC CO., LTD.

あて名 〒352-8666 日本国埼玉県新座市北野3丁目6番3号

6-3, Kitano 3-chome, Niiza-shi, Saitama 352-8666, JAPAN

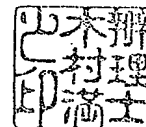
国籍 日本国 Japan

住所 日本国 Japan

3. 代理人

氏名 (9540) 弁理士 木村 満

KIMURA Mitsuru



あて名 〒101-0054 日本国東京都千代田区神田錦町二丁目

7番地 協販ビル2階

2nd Floor, Kyohan Building, 7, Kandanishiki-cho 2-chome,

Chiyoda-ku, Tokyo 101-0054, JAPAN

4. 補正の対象 請求の範囲

5. 補正の内容

(1) 請求の範囲第1項

第8行「前記第2の半導体領域(3)を介して」との記載を追加した。

第10行「前記第1の半導体領域(2)と前記第2の半導体領域(3)と前記第3の半導体領域(6)とによってリサーフ構造が形成される」との記載を追加した。

第14行「隣接して」との記載を追加した。

第15行「前記リサーフ構造を形成する前記第3の半導体領域(6)の」との記載を追加した。

第18行および第19行「第2の」と誤記を訂正した。

第20行「ために電荷量が該周縁部(6b)の真下の該第2半導体領域(3)の電荷量よりも少ない」との記載を削除した。

(2) 請求の範囲第3項

第2行および第3行「第2の」と誤記を訂正した。

従属先を請求項1に変更した。

(3) 請求の範囲第4項

第5行「前記第3の半導体領域(6)は、前記第2の半導体領域(3)の表面の略中央に形成されており」との記載を削除した。

第6行「、前記中央部(6a)は、前記第4の半導体領域の真下に形成され」との記載を追加した。

従属先を請求項1に変更した。

(4) 請求の範囲第5項

第8行「第2の半導体領域(3)の外周縁に形成された第1導電型の」との記載を追加した。

第10行「第5の半導体領域(8)上に形成された」との記載を追加した。

第 1 1 行「第 4 の半導体領域（7）上に形成された」との記載を追加した。

（5）請求の範囲第 6 項

従属先を請求項 1 に変更した。

（6）請求の範囲第 7 項

「前記中央部（6 a）の真下に配置された前記第 2 の半導体領域（3）の電荷量が該周縁部（6 b）の真下の該第 2 の半導体領域（3）の電荷量よりも少ない」との内容に補正した。

（7）請求の範囲第 8 項

第 3 行「、前記第 1 の半導体領域（2）と前記第 2 の半導体領域（3）と前記第 3 の半導体領域（6）とがリサーフ構造を構成するよう」との記載を、元の請求の範囲第 7 項の内容に追加したものを新たな請求項として追加した。

6. 添付書類の目録

請求の範囲第 1 3、1 3 / 1、1 4、1 4 / 1、1 5 頁